




PŘEDNÁŠKA

KARBID KŘEMÍKU: Růst krystalu z plynné fáze

Matematicko-fyzikální fakulta UK, Ke Karlovu 5,
Posluchárna F2

- 
- Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku o **technologii růstu krystalu SiC**
 - Získejte jedinečné poznatky o trendech a pokrocích v oblasti **technologie SiC**
 - Zjistěte, jak lze využít **počítačové simulace** v oblasti materiálových věd

14:10

2.4.2025

Łukasz Kantor

Łukasz Kantor působí jako inženýr v R&D týmu ve společnosti onsemi v Rožnově pod Radhoštěm, kde se zabývá růstem monokrystalů a polykrystalů karbidu křemíku (SiC) metodou Physical Vapor Transport (PVT) a také počítačovým modelováním tohoto procesu. Je absolventem oboru Materiálové inženýrství na VŠB – Technické univerzitě Ostrava a nyní je studentem doktorského studijního programu Materiálové vědy a inženýrství. Během svého vysokoškolského studia působil v onsemi jako stážista na oddělení SiC R&D, kde se zabýval počítačovým modelováním růstu krystalů SiC metodou PVT. Na práci ve výzkumu se mu líbí především využití nabytých teoretických znalostí, jejich aplikace v experimentech a také možnost přispívat k inovacím v oblasti polovodičových materiálů.



LECTURE

SILICON CARBIDE: Crystal growth from the gas phase

Faculty of Mathematics and Physics, Charles University,
Ke Karlovu 5, Auditorium F2



- Come and listen to an interesting lecture on **SiC crystal growth technology**
- Gain unique insights into trends and advancements in SiC technology
- Find out how computer simulations can be used in materials science

14:10

2.4.2025

Łukasz Kantor

Łukasz Kantor works as a material science engineer in the R&D team at onsemi in Rožnov pod Radhoštěm. He focuses on the growth of single crystals and polycrystals of silicon carbide (SiC) using the Physical Vapor Transport (PVT) method and also the computer modeling of this process. He graduated from the Department of Materials Engineering at VŠB – Technical University of Ostrava and is currently a doctoral student in the Materials Science and Engineering program. During his university studies, he worked as an intern at the SiC R&D department at onsemi, where he dealt with computer modeling of SiC crystal growth by the PVT method. What he enjoys most about working in research is the utilization of acquired theoretical knowledge, its application in experiments, and the opportunity to contribute to innovations in the field of semiconductor materials.